

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2000-17422(P2000-17422A)

【公開日】平成12年1月18日(2000.1.18)

【出願番号】特願平10-191769

【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 14/04

C 2 3 C 16/04

G 0 2 B 5/20

H 0 1 L 21/203

H 0 1 L 21/285

【F I】

C 2 3 C 14/04 A

C 2 3 C 16/04

G 0 2 B 5/20

H 0 1 L 21/203 S

H 0 1 L 21/285 S

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月6日(2005.7.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

マスクの基板と接触する側とは反対の面の表層に凹凸を設けたことを特徴とする導電膜パターン化用マスク。

【請求項2】

上記凹凸を形成した面の中心線平均粗さRaが0.1から5μmの範囲内であることを特徴とする請求項1記載の導電膜のパターン化用マスク。

【請求項3】

上記凹凸をサンドブラスト処理により表層を粗らすことで形成することを特徴とする請求項1または2に記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項4】

上記凹凸をエッチングにより形成することを特徴とする請求項1または2に記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項5】

上記凹凸をハーフエッチングにより、マスクの厚み方向に部分的に窪みを付けることで形成することを特徴とする請求項1、2または4のいずれかに記載の導電膜パターン化用マスク。

【請求項6】

請求項1～5のいずれかに記載のパターン化用マスクを用いることを特徴とする透明導電膜の製膜方法。